

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006073

International filing date: 30 March 2005 (30.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-106521
Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

30.3.2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日
Date of Application:

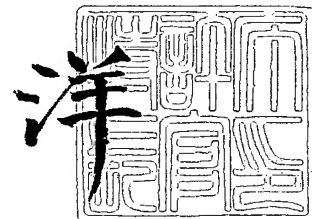
出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 1 0 6 5 2 1
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 4 - 1 0 6 5 2 1]

出 願 人 日 本 電 気 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 0 月 1 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 34601892
【提出日】 平成16年 3月31日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G01R 33/02
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内
 【氏名】 安道 徳昭
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内
 【氏名】 増田 則夫
【特許出願人】
 【識別番号】 000004237
 【氏名又は名称】 日本電気株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100117226
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 吉村 俊一
 【電話番号】 03-3947-4103
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 176752
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0211103

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

基板と、該基板上に形成された積層コイルと、該積層コイルに連なって前記基板上に形成されたストリップ線路とを備え、

前記積層コイルは、導電体層により形成された少なくとも 2 つのコイル形成要素が、隣り合うもの同士の間層間絶縁膜を介して、かつ、隣り合うもの同士がヴィアコンタクトした状態で前記基板上に積層された構造を有していると共に、1 よりも大きなターン数を有しており、

前記ストリップ線路は、下部グランド層、下部層間絶縁膜、ストリップ導体、上部層間絶縁膜、及び上部グランド層がこの順番で前記基板上に積層された構造を有しており、

前記積層コイルの一端が前記下部グランド層及び前記上部グランド層のいずれか一方のグランド層に連なっており、前記積層コイルの他端が前記ストリップ導体に連なっていることを特徴とする磁界センサ。

【請求項 2】

前記積層コイルのターン数が、前記少なくとも 2 つのコイル形成要素の総数以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の磁界センサ。

【請求項 3】

前記積層コイルの平面視上の輪郭形状が矩形であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の磁界センサ。

【請求項 4】

前記少なくとも 2 つのコイル形成要素の総数が 2 又は 3 であることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【請求項 5】

前記少なくとも 2 つのコイル形成要素のうちで前記基板を基準にしたときに最下層に相当するコイル形成要素及び最上層に相当するコイル形成要素のいずれか一方が前記一方のグランド層に連なっており、他方が前記ストリップ導体に連なっていることを特徴とする請求項 4 に記載の磁界センサ。

【請求項 6】

前記一方のグランド層と該一方のグランド層に連なるコイル形成要素とが 1 つの導電体層によって形成されており、前記ストリップ導体と該ストリップ導体に連なるコイル形成要素とが他の 1 つの導電体層によって形成されていることを特徴とする請求項 4 又は 5 に記載の磁界センサ。

【請求項 7】

前記少なくとも 2 つのコイル形成要素の総数が 4 であることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【請求項 8】

前記少なくとも 2 つのコイル形成要素のうちで前記基板を基準にしたときに最下層に相当するコイル形成要素及び最上層に相当するコイル形成要素のいずれか一方が前記一方のグランド層に連なっており、残り 3 つのコイル形成要素のうちの真中に位置するコイル形成要素に近接して、前記ストリップ導体に連なる引き出し部が形成されており、前記最下層に相当するコイル形成要素及び前記最上層に相当するコイル形成要素のうちの他方が前記引き出し部とヴィアコンタクトしていることを特徴とする請求項 7 に記載の磁界センサ。

【請求項 9】

前記上部グランド層及び前記下部グランド層それぞれの平面形状が、前記積層コイル側の端部での線幅が他の領域での線幅よりも広がって矩形領域を形成した T 字状であることを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【請求項 10】

前記ストリップ導体を平面視したときに、該ストリップ導体が前記矩形領域での基部側の長辺の中点及び前記矩形領域の中心点を通り、かつ、前記中心点で方向を 90° 変えて

前記矩形領域での短辺の中点を通る中心線に沿って延び、前記短辺に達する前に前記積層コイルに向かう方向へと再び 90° 方向を変えて前記矩形領域での積層コイル側の長辺に達していることを特徴とする請求項 9 に記載の磁界センサ。

【請求項 1 1】

前記ストリップ導体の線幅が一定であり、かつ、前記矩形領域の短辺の長さが前記ストリップ導体の線幅の 4 ～ 8 倍であること特徴とする請求項 9 又は 1 0 に記載の磁界センサ。

【請求項 1 2】

前記ストリップ導体を平面視したときに、該ストリップ導体での前記積層コイル側の端と、前記矩形領域の短辺のうちで前記端に最寄りの短辺との間隔が、前記ストリップ導体の線幅の 2 倍以上であることを特徴とする請求項 1 1 に記載の磁界センサ。

【請求項 1 3】

前記下部グランド層及び前記上部グランド層それぞれの平面形状が帯状であることを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【請求項 1 4】

前記ストリップ導体上での前記上部層間絶縁膜の膜厚が、前記ストリップ導体下での前記下部層間絶縁膜の膜厚と実質的に同じであることを特徴とする請求項 1 ～ 1 3 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【請求項 1 5】

前記ストリップ線路が、前記下部グランド層と前記上部グランド層とによって外周面が形成されたシールド型ストリップ線路領域を含むことを特徴とする請求項 1 ～ 1 4 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【請求項 1 6】

前記ストリップ線路の特性インピーダンスが、該ストリップ線路の一端に接続される高周波ケーブルの特性インピーダンス、もしくは、前記ストリップ線路と高周波ケーブルとを中継する伝送線路の特性インピーダンスと同じ値であることを特徴とする請求項 1 ～ 1 5 のいずれか 1 項に記載の磁界センサ。

【書類名】明細書

【発明の名称】磁界センサ

【技術分野】

【0001】

本発明は、磁界センサに関し、更に詳しくは、電磁誘導された起電力を検出することによって高周波の磁界を検知することができる磁界センサに関する。

【背景技術】

【0002】

今日では、電子機器の高性能化、高機能化が急速に進んでおり、これに伴って、個々の電子機器又は電子回路から放射される電磁波も強まっている。電子機器又は電子回路から強い電磁波が放射されると、この電磁波によって周囲の電子機器又は電子回路が誤動作することがある。

【0003】

強い電磁波が放射される原因の1つとして、回路を流れる不要な高周波電流、特に半導体装置の電源供給配線を流れる高周波ノイズ電流が知られており、設計あるいは製造の早期からこの高周波ノイズ電流を抑制することが望まれている。

【0004】

近傍磁界強度を計測することにより、高周波ノイズ電流の経路を非接触の検査で特定することができるので、設計あるいは製造の早期から高周波ノイズ電流の抑制効果を検証することが可能となり、結果として電磁波対策を講じることが可能になる。コイルに誘導される起電力を測定して磁界を検知するタイプのセンサとしては、例えば下記特許文献1～5に記載されたものが知られている。

【0005】

特許文献1に記載された磁界センサは、各々がC字状に成形された1対の誘電体配線基板それぞれに、誘電体配線基板と平面視上重なる形状及び大きさを有する接地導体を設け、かつ、これら1対の誘電体基板によって所定形状のストリップ導体を挟持した構造を有し、ストリップ導体の始端位置と各接地導体との間の誘起電圧を磁界検出出力とするものである。

【0006】

この磁界センサにおける各誘電体基板は、接地導体が外表面となるようにして互いに対向配置されており、ストリップ導体と各接地導体とは、ストリップ導体の終端位置で電気的に接続されている。各接地導体は、ストリップ導体を外部電界からシールドする機能を果たす。ストリップ導体の終端位置は、誘電体配線基板においてギャップ部（C字状をなすための切り欠き部）を挟んで互いに対向する2つの端部の一方にある。このストリップ導体は、終端位置からギャップ部を渡って誘電体基板におけるC字状の一方の半周部に沿って延び、この半周部の所定位置を始端位置としている。

【0007】

特許文献2に記載された磁界センサは、各々が所定形状の導体パターンを有する第1層、第2層、及び第3層を各層の間に絶縁層を介在させた状態で、かつ、第2層の導体パターンを第1層及び第3層それぞれの導体パターンと接続させた状態で積層した構造を有し、第2層の導体パターンと第1層及び第3層それぞれの導体パターンの間に接続された負荷に発生した電圧を検出して磁界出力とするものである。この磁界センサでは、各導体パターンの形状が、これらを平面視したときに1ターンのループコイルを形成するように選定されている。第1層及び第3層の導体パターンは、それぞれ、第2層の導体パターンを外部電界からシールドする機能を果たす。

【0008】

特許文献3に記載されたペン型近磁界プローブは、微小ループコイル、伝送線路、及び高周波ケーブル用接続部がそれぞれ形成されたプリント配線基板（支持体）を保持部の先端に接続した構造を有するものである。

【0009】

特許文献4に記載された密着固定型近磁界プローブは、シート状の基板上に1ターンのループコイル、コプレナ伝送線路、及び高周波コネクタを設け、この基板の裏面に剥離可能な接着面を設けることにより、又は、上記の基板に線材に係合可能な係合部を設けることにより、測定対象に対し接着、剥離可能にしたものである。

【0010】

特許文献5に記載された近磁界プローブは、1ターンのループコイルと、このループコイルに接続された伝送回路とを誘電体に設けた構造を有し、前記伝送回路のインピーダンスを伝送方向に漸次変化させることによって出力電圧の低下を抑制したものである。

【特許文献1】特開平10-82845号公報（特許請求の範囲、第0013～0017段、図1、及び図2参照）

【特許文献2】特開2000-171535号公報（特許請求の範囲、第0011～0017段、図1、及び図2参照）

【特許文献3】特開2000-121712号公報（特許請求の範囲、図2、及び図3参照）

【特許文献4】特開2000-147034号公報（特許請求の範囲及び図1参照）

【特許文献5】特開2003-207531号公報（特許請求の範囲、第0008段、及び図1～図5参照）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

例えば半導体集積回路は、年々、微細化されており、微細な電子回路に流れる高周波ノイズ電流の経路の特定や、個々の配線に流れる電流値の評価を行うためには、磁界センサの空間分解能を高めることが必要である。

【0012】

しかしながら、特許文献1～5に記載されたいずれのセンサも、1ターンのループコイルに誘導される起電力に基づいて磁界を検知するものであるので、ループコイルを微細化すると当該ループコイルを貫く磁束も減少して検出感度が低下する。この構造のループコイルでは、実用に耐える検出感度を維持しつつ微細化を図ることが困難であり、結果として、センサの空間分解能を高めることが困難である。

【0013】

また、特許文献1に記載された磁界センサでは、ストリップ導体を外部電界からシールドするための接地導体それぞれの線幅をストリップ導体の線幅よりも広くしなければならないので、この磁界センサでは、電磁波の発生場所を特定する際の検査対象物との最短距離を、接地導体を平面視したときのストリップ導体の終端位置と当該接地導体の外周面との最短距離よりも縮めることができない。この点からも、特許文献1に記載された磁界センサでは、空間分解能を向上させ難い。同様のことが、特許文献2に記載された磁界センサについてもいえる。

【0014】

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、高空間分解能化を図ることが容易な磁界センサを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0015】

上記の目的を達成する本発明の磁界センサは、基板と、該基板上に形成された積層コイルと、該積層コイルに連なって前記基板上に形成されたストリップ線路とを備え、前記積層コイルは、導電体層により形成された少なくとも2つのコイル形成要素が、隣り合うもの同士の間層間絶縁膜を介して、かつ、隣り合うもの同士がヴィアコンタクトした状態で前記基板上に積層された構造を有していると共に、1よりも大きなターン数を有しており、前記ストリップ線路は、下部グランド層、下部層間絶縁膜、ストリップ導体、上部層間絶縁膜、及び上部グランド層がこの順番で前記基板上に積層された構造を有しており、前記積層コイルの一端が前記下部グランド層及び前記上部グランド層のいずれか一方のグ

ランド層に連っており、前記積層コイルの他端が前記ストリップ導体に連っていることを特徴とする（以下、この磁界センサを「磁界センサI」ということがある。）。

【0016】

本発明の磁界センサIでは、上記積層コイルのターン数が1よりも大きいので、この積層コイルを貫く磁束が大きくなるため比較的大きな起電力を誘導させることが可能である。したがって、積層コイルを小型化しても検出感度を高く保つことが可能である。また、積層コイルの形状及び大きさを、測定対象物に近接させ易い形状及び大きさに設計することが容易である。したがって、本発明の磁界センサIによれば、高空間分解能化を図ることが容易になる。

【0017】

本発明の磁界センサIにおいては、（1）前記積層コイルのターン数が、前記少なくとも2つのコイル形成要素の総数以上である（以下、この磁界センサを「磁界センサII」ということがある。）こと、が好ましい。

【0018】

本発明の磁界センサIIによれば、積層コイルのターン数がコイル形成要素の総数以上であるので、検出感度を容易に高めることができ、積層コイルを小型化しても実用的な検出感度を得易いため、小型化により高空間分解能の磁界センサを効率よく得ることが容易になる。

【0019】

本発明の磁界センサI及び磁界センサIIにおいては、（2）前記積層コイルの平面視上の輪郭形状が矩形である（以下、この磁界センサを「磁界センサIII」ということがある。）こと、が好ましい。

【0020】

本発明の磁界センサIIIによれば、積層コイルの平面視上の輪郭形状が矩形であるので、例えば積層コイルの平面視上の輪郭形状を円形にした場合に比べて、積層コイルを測定対象物に近接させた際に当該積層コイルを貫く磁束を増加させることが可能であり、その結果として、高感度化を図ることが更に容易になる。

【0021】

本発明の磁界センサI～IIIのいずれにおいても、（3）前記少なくとも2つのコイル形成要素の総数が2又は3である（以下、この磁界センサを「磁界センサIV」ということがある。）こと、とすることができる。

【0022】

本発明の磁界センサIVにおいては、（4）前記少なくとも2つのコイル形成要素のうちで前記基板を基準にしたときに最下層に相当するコイル形成要素及び最上層に相当するコイル形成要素のいずれか一方が前記一方のランド層に連っており、他方が前記ストリップ導体に連っている（以下、この磁界センサを「磁界センサV」ということがある。）こと、とすることができる。

【0023】

本発明の磁界センサVによれば、この磁界センサVが上記の構造を有しているので、ストリップ導体を外部電界からシールドすることが容易になる。

【0024】

本発明の磁界センサIV及び磁界センサVのいずれにおいても、（5）前記一方のランド層と該一方のランド層に連なるコイル形成要素とが1つの導電体層によって形成されており、前記ストリップ導体と該ストリップ導体に連なるコイル形成要素とが他の1つの導電体層によって形成されている（以下、この磁界センサを「磁界センサVI」ということがある。）こと、が好ましい。

【0025】

本発明の磁界センサVIによれば、1つの導電膜をパターンニングして1つのコイル形成要素と1つのランド層とを形成し、他の1つの導電膜をパターンニングして他の1つのコイル形成要素とストリップ導体とを形成することが可能であるので、その製造が容易になる

【0026】

前述した本発明の磁界センサI～磁界センサIIIにおいては、(6)前記少なくとも2つのコイル形成要素の総数が4である(以下、この磁界センサを「磁界センサVII」ということがある。)こと、とすることができる。

【0027】

本発明の磁界センサVIIにおいては、(7)前記少なくとも2つのコイル形成要素のうちで前記基板を基準にしたときに最下層に相当するコイル形成要素及び最上層に相当するコイル形成要素のいずれか一方が前記一方のグランド層に連なっており、残り3つのコイル形成要素のうちの真中に位置するコイル形成要素に近接して、前記ストリップ導体に連なる引き出し部が形成されており、前記最下層に相当するコイル形成要素及び前記最上層に相当するコイル形成要素のうちの他方が前記引き出し部とヴィアコンタクトしている(以下、この磁界センサを「磁界センサVIII」ということがある。)こと、が好ましい。

【0028】

本発明の磁界センサVIIIによれば、この磁界センサVIIIが上記の構造を有しているので、ストリップ導体を外部電界からシールドすることが容易になる。

【0029】

上述した本発明の磁界センサI～磁界センサVIIIのいずれにおいても、(8)前記上部グランド層及び前記下部グランド層それぞれの平面形状が、前記積層コイル側の端部での線幅が他の領域での線幅よりも広がって矩形領域を形成したT字状である(以下、この磁界センサを「磁界センサIX」ということがある。)こと、とすることができる。

【0030】

本発明の磁界センサIXにおいては、(9)前記ストリップ導体を平面視したときに、該ストリップ導体が前記矩形領域での基部側の長辺の中点及び前記矩形領域の中心点を通り、かつ、前記中心点で方向を90°変えて前記矩形領域での短辺の中点を通る中心線に沿って延び、前記短辺に達する前に前記積層コイルに向かう方向へと再び90°方向を変えて前記矩形領域での積層コイル側の長辺に達している(以下、この磁界センサを「磁界センサX」ということがある。)こと、(10)前記ストリップ導体の線幅が一定であり、かつ、前記矩形領域の短辺の長さが前記ストリップ導体の線幅の4～8倍である(以下、この磁界センサを「磁界センサXI」ということがある。)こと、とすることができる。

【0031】

本発明の磁界センサXIにおいては、(11)前記ストリップ導体を平面視したときに、該ストリップ導体での前記積層コイル側の端と、前記矩形領域の短辺のうちで前記端に最寄りの短辺との間隔が、前記ストリップ導体の線幅の2倍以上である(以下、この磁界センサを「磁界センサXII」ということがある。)こと、とすることができる。

【0032】

また、前述した本発明の磁界センサI～磁界センサVIIIのいずれにおいも、(12)前記下部グランド層及び前記上部グランド層それぞれの平面形状が帯状である(以下、この磁界センサを「磁界センサXIII」ということがある。)こと、とすることができる。

【0033】

上述した本発明の磁界センサI～磁界センサXIIIのいずれにおいても、(13)前記ストリップ導体上での前記上部層間絶縁膜の膜厚が、前記ストリップ導体下での前記下部層間絶縁膜の膜厚と実質的に同じである(以下、この磁界センサを「磁界センサXIV」ということがある。)こと、(14)前記ストリップ線路が、前記下部グランド層と前記上部グランド層とによって外周面が形成されたシールド型ストリップ線路領域を含む(以下、この磁界センサを「磁界センサXV」ということがある。)こと、又は、(15)前記ストリップ線路の特性インピーダンスが、該ストリップ線路の一端に接続される高周波ケーブルの特性インピーダンス、もしくは、前記ストリップ線路と高周波ケーブルとを中継する伝送線路の特性インピーダンスと同じ値である(以下、この磁界センサを「磁界センサXVI」ということがある。)こと、が好ましい。

【0034】

本発明の磁界センサXIVによれば、第1絶縁層の膜厚と第2絶縁層の膜厚とが実質的に同じ値であるので、ストリップ線路の特性インピーダンスを所望の値に制御することが容易になる。

【0035】

本発明の磁界センサXVによれば、ストリップ線路がシールド型ストリップ線路領域を含んでいるので、ストリップ導体を外部電界からシールドすることが容易になり、結果として、S/N比を高めることが容易になる。

【0036】

本発明の磁界センサXVIによれば、積層コイルと当該積層コイルに誘導された起電力を計測する計測機器との間での伝送損失を抑えることが容易になる。なお、上記の伝送線路には、通常、高周波ケーブルが接続され、この高周波ケーブルの特性インピーダンスと前記伝送線路の特性インピーダンスとは、多くの場合、同じ値に調整される。

【発明の効果】

【0037】

本発明の磁界センサによれば、高空間分解能化を図ることが容易になるので、例えば微細な電子回路に流れる高周波ノイズ電流を測定することが容易になり、電子機器や電子回路の設計あるいは製造の早期から電磁波対策を講じることが容易になる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0038】

<第1形態>

図1は、本発明に係る第1形態の磁界センサを概略的に示す分解斜視図である。同図に示すように、本形態の磁界センサ30は、基板1と、基板1上に形成された積層コイル10と、積層コイル10に連なって基板1上に形成されたストリップ線路20とを有している。

【0039】

積層コイル10は、基板1上にコイル部第1層間絶縁膜11、第1コイル形成要素12、コイル部第2層間絶縁膜13、及び第2コイル形成要素14をこの順番で積層した構造を有しており、コイル部第2層間絶縁膜13には、第1コイル形成要素12と第2コイル形成要素14とを互いにビアコンタクトさせるコンタクトプラグ19が形成されている。一方、ストリップ線路20は、基板1上に下部グランド層21、線路部第1層間絶縁膜22、ストリップ導体23、線路部第2層間絶縁膜24、及び上部グランド層27をこの順番で積層した構造を有している。以下、基板1、積層コイル10、及びストリップ線路20それぞれについて、図1及び後掲の図2～図6を参照して詳述する。

【0040】

(1) 基板;

基板1としては、例えばガラス基板、サファイア基板等の電気絶縁性基板を用いることができ、その厚は1 μ m程度以下の範囲内で適宜選定可能である。また、パッケージが開封された半導体集積回路のチップ上で測定を行う場合に、例えばボンディングワイヤ等の障害物に磁界センサ30が当たる状況をなるべく防ぐという観点からは、基板1をできるだけ薄肉にすることが好ましい。

【0041】

(2) 積層コイル;

積層コイル10は、上述のように、コイル部第1層間絶縁膜11、第1コイル形成要素12、コイル部第2層間絶縁膜13、及び第2コイル形成要素14の積層体である。

【0042】

コイル第1層間絶縁膜11は、基板1上に形成されて第1コイル形成要素12を設けるための平坦面を形成しており、その平面形状は矩形である。また、コイル部第2層間絶縁膜13は、第1コイル形成要素12上に形成されて第2コイル形成要素14を設けるための平坦面を形成しており、この第2コイル形成要素14の平面形状も矩形である。

【0043】

図2は磁界センサ30を概略的に示す斜視図であり、図3は図2に示したIII-III線断面の概略図である。これらの図に示すように、コイル部第2層間絶縁膜13は第1コイル形成要素12を被覆している。コイル部第1層間絶縁膜11とコイル部第2層間絶縁膜13とは、平面視上、互いに重なり合う。

【0044】

このようなコイル部第1層間絶縁膜11及びコイル部第2層間絶縁膜13は、例えば、フォトレジスト、ケイ素酸化物等を材料として用いてスピコート、スパッタ等の方法により大形の電気絶縁膜を成膜し、この電気絶縁膜をエッチング等の方法を利用して所定形状にパターンニングすることによって作製することができる。コイル部第1層間絶縁膜11及びコイル部第2層間絶縁膜13それぞれの膜厚は、いずれも、0.5～3 μm 程度の範囲内で適宜選定可能である。

【0045】

また、コイル部第2層間絶縁膜13に形成されているコンタクトプラグ19（図1参照）は、コイル部第2層間絶縁膜13にビアホール（接続孔）を設け、このビアホールを例えば銅やアルミニウム等の導電性材料により埋めることで作製される。磁界センサ30の導体抵抗を低く抑えるうえからは、導電性の高い材料によりコンタクトプラグ19を形成することが好ましい。コンタクトプラグ19によって第1コイル形成要素12と第2コイル形成要素14とを接続することにより、これらのコイル形成要素12、14を互いにビアコンタクトさせることができる。

【0046】

第1コイル形成要素12及び第2コイル形成要素14は、コンタクトプラグ19により互いに接続されて、ターン数が3よりもやや小さいコイルを形成している。基板1を基準にすると、第1コイル形成要素12が最下層のコイル形成要素に相当し、第2コイル形成要素14が最上層のコイル形成要素に相当する。

【0047】

第1コイル形成要素12のターン数は2よりもやや小さく、第2コイル形成要素14のターン数は1よりもやや大きい。これらのコイル形成要素12、14は、例えば、銅、アルミニウム等の導電性材料を用いてめっき、物理的气相蒸着法（PVD）、化学的气相蒸着法（CVD）等により形成した導電体層を、エッチング等の方法により所定形状にパターンニングすることによって作製することができる。積層コイル10を小型化して磁界センサ30の空間分解能を高めるうえからは、銅やアルミニウムのように導電性の高い材料により各コイル形成要素12、14を作製することが好ましい。

【0048】

各コイル形成要素12、14の膜厚は0.5～4 μm 程度の範囲内で、また、その線幅は1～4 μm 程度の範囲内で、それぞれ適宜選定可能である。磁界センサ30の空間分解能を高めるという観点からは、これらのコイル形成要素12、14の線幅を、それぞれ1～2.5 μm 程度の範囲内で選定することが好ましい。

【0049】

同様の観点から、積層コイル10の平面視上の輪郭形状は、各短辺がストリップ線路20の長手軸と平行な矩形とすることが好ましい。積層コイル10の形状をこのように選定することにより、その平面視上の輪郭形状を例えば円形にした場合に比べて、積層コイル10を測定対象物に近接させた際に当該積層コイル10を貫く磁束を増加させることが可能になり、結果として、積層コイル10を小型化しても磁界センサ30の検出感度を高く保ち易くなる。空間分解能が高い磁界センサ30を得ようとする場合、積層コイル10の輪郭の平面視上の大きさ及び形状は、上記短辺の長さが10～40 μm 程度で、長辺の長さが20～500 μm 程度の矩形とすることが特に好ましい。

【0050】

なお、本発明でいう「積層コイルの平面視上の輪郭形状」とは、各コイル形成要素とこれらを電氣的に接続するコンタクトプラグとによって形成されたコイル本体を平面視した

ときに、巻回部分が呈する輪郭形状を意味する。本形態の磁界センサ 30 では、第 1 コイル形成要素 12 と第 2 コイル形成用要素 14 とが部分的に互いに重なり合って、図 4 に示すように、巻回部分の平面視上の輪郭形状が矩形であるコイル本体 C1 を形成している。図 4 に示した部材のうちで図 1 に示されているものについては、図 1 で用いた参照符号と同じ参照符号を付してある。

【0051】

(3) ストリップ線路;

ストリップ線路 20 は、前述のように、下部グランド層 21、線路部第 1 層間絶縁膜 22、ストリップ導体 23、線路部第 2 層間絶縁膜 24、及び上部グランド層 27 の積層体である。

【0052】

下部グランド層 21 は、図 1 又は図 2 に示すように、積層コイル 10 側の端部での線幅が他の領域 21a での線幅よりも広がって矩形領域 21b を形成している導電体層であり、その平面形状は T 字状である。この下部グランド層 21 は、例えば銅、アルミニウム等の導電性材料を用いて、めっき、PVD、CVD 等の方法により形成した導電体層を、エッチング等の方法を利用して所定形状にパターニングすることによって作製することができる。また、所定形状のマスクを用いた PVD 又は CVD により上述の導電性材料を基板 1 上に堆積させることによっても形成可能である。

【0053】

下部グランド層 21 の膜厚は、その材料の導電性に応じて、1~5 μm 程度の範囲内で適宜選定可能である。また、矩形領域 21b を平面視したときの短辺（ストリップ線路 20 の長手軸と平行に延びている辺を意味する。）の長さは、この矩形領域 21b と後述する矩形領域 27b とによる電界シールド効果をできるだけ高めるという観点から、ストリップ導体 23 の線幅の 4 倍程度以上とすることが好ましい。また、空間分解能が高い磁界センサ 30 を得るという観点からは、上記の短辺の長さを、ストリップ導体 23 の線幅の 8 倍程度以下とすることが好ましい。矩形領域 21b を平面視したときの長辺（ストリップ線路 20 の長手軸と平面視上直交する方向に延びている辺を意味する。）の長さは、積層コイル 10 の大きさに応じて、25~550 μm 程度の範囲内で適宜選定可能である。

【0054】

線路部第 1 層間絶縁膜 22 は、図 1 に示すように、積層コイル 10 側の端部での線幅が他の領域 22a での線幅よりも広がって矩形領域 22b を形成している電気絶縁膜であり、その平面形状は T 字状である。領域 22a の線幅は、下部グランド層 21 での領域 21a の線幅よりも狭く、矩形領域 22b は下部グランド層 21 での矩形領域 21b よりも大形である。線路部第 1 層間絶縁膜 22 の上面は平坦面となっている。

【0055】

この線路部第 1 層間絶縁膜 22 は、図 1~図 3 に示すように、矩形領域 21b を被覆して当該矩形領域 21b とストリップ導体 23 との短絡を防止していると共に、領域 21a 上においてストリップ導体 23 と領域 21a との短絡を防止している。下部グランド層 21 上での線路部第 1 層間絶縁膜 22 の膜厚は、1~10 μm 程度の範囲内で適宜選定可能である。ストリップ線路 20 においては、線路部第 1 層間絶縁膜 22 が下部層間絶縁膜に相当する。

【0056】

線路部第 1 層間絶縁膜 22 の矩形領域 22b には、前述したコイル部第 1 層間絶縁膜 11 が連なっている（図 1~図 3 参照）。このような線路部第 1 層間絶縁膜 22 及びコイル部第 1 層間絶縁膜 11 は、例えば互いに別個に形成することもできるが、大形の電気絶縁層を所定形状にパターニングすることによって両者を一時に形成した方が簡便である。この場合、積層コイル 10 とストリップ線路 20 との境界が線路部第 1 層間絶縁膜 22 とコイル部第 1 層間絶縁膜 11 との境界となる。積層コイル 10 とストリップ線路 20 との境界は、図 3 に示すように、下部グランド層 21 及び矩形領域 22b それぞれにおける積層コイル 10 側の端面を含む垂直面 VF であり、前記の各端面はストリップ線路 20 に含ま

れる。

【0057】

ストリップ導体23は、電磁誘導された起電力を測定するための計測機器（図示せず。）に積層コイル10を接続するための導体であり、このストリップ導体23の一端には例えば高周波ケーブルが接続される。高周波ケーブルと同じ値の特性インピーダンスを有する伝送線路をストリップ導体23と高周波ケーブルとの間に介在させ、この伝送線路によってストリップ導体23と高周波ケーブルとを中継してもよい。高周波ケーブルの一端は上記の計測機器に接続される。ストリップ導体23の線幅は、1～4 μ m程度の範囲内で適宜選定可能である。この線幅は、所望の特性インピーダンスを有するストリップ線路20を容易に形成するうえから、一定であることが好ましい。ストリップ導体23の膜厚は、0.5～2 μ m程度の範囲内で適宜選定可能である。

【0058】

ストリップ導体23の平面形状は、図1に示すように、線路部第1層間絶縁膜22の領域22a上においては直線状であり、線路部第1層間絶縁膜22の矩形領域22b上においてはクランク状に折れ曲がった形状である。図5は、矩形領域22b上でのストリップ導体23の形状を概略的に示す平面図である。同図に示すように、矩形領域22b上でのストリップ導体23は、平面視上、下部グランド層21の矩形領域21bにおける基部側（領域21a側を意味する。）の長辺L1の中点P1及び矩形領域21bの中心点Oを通り、かつ、中心点Oで方向を90°変えて矩形領域21bでの短辺S1の中点P2を通る中心線CLに沿って延び、短辺S1に達する前に積層コイル10に向かう方向へと再び90°方向を変えて、矩形領域21bでの積層コイル10側の長辺L2に達する形状を有している。下部グランド層21の矩形領域21bと後述する上部グランド層の矩形領域27bとによってストリップ導体23を外部電界からできるだけシールドするという観点から、ストリップ導体23における積層コイル10側の端と、下部グランド層21の矩形領域21bの短辺のうちで前記の端に最寄りの短辺S1との平面視上の間隔を、ストリップ導体23の線幅の2倍以上とすることが好ましい。ストリップ導体23の平面形状を上述のような形状にすることにより、ストリップ導体23を外部電界からシールドすることが容易になる。

【0059】

このストリップ導体23の一端には、前述した積層コイル10の一端（第1コイル形成要素12の一端）が連なっている（図1又は図3参照）。このようなストリップ導体23と第1コイル形成要素12とは、例えば互いに別個に形成することもできるが、大形の導電体層を所定形状にパターンニングすることによって両者を一時に形成した方が簡便である。

【0060】

線路部第2層間絶縁膜24は、線路部第1層間絶縁膜22と同様に、積層コイル10側の端部での線幅が他の領域24aでの線幅よりも広がって矩形領域24bを形成している電気絶縁膜であり、その平面形状はT字状である（図1参照）。この線路部第2層間絶縁膜領域24の平面形状及び大きさは前述した線路部第1層間絶縁膜22の平面形状及び大きさと同じであり、これら2つの線路部層間絶縁膜は、平面視上、互いに重なり合う。線路部第2層間絶縁膜の上面は平坦面となっている。

【0061】

このような形状を有する線路部第2層間絶縁膜24は、図1～図3に示すように、ストリップ導体23を被覆して、当該ストリップ導体23と上部グランド層27との短絡を防止している。ストリップ導体23上での線路部第2層間絶縁膜24の膜厚は、1～10 μ m程度の範囲内で適宜選定可能であるが、ストリップ線路20の特性インピーダンスを所望の値に容易に制御可能であるという観点から、下部グランド層21上での線路部第1層間絶縁膜22の膜厚と実質的に同じ膜厚にすることが好ましい。ストリップ線路20においては、線路部第2層間絶縁膜24が上部層間絶縁膜に相当する。

【0062】

線路部第2層間絶縁膜24の矩形領域24bには、前述したコイル部第2層間絶縁膜13が連なっている（図1～図3参照）。このような線路部第2層間絶縁膜24及びコイル部第2層間絶縁膜13は、例えば互いに別個に形成することもできるが、大形の電気絶縁層を所定形状にパターンニングすることによって両者を一時に形成した方が簡便である。

【0063】

上部グランド層27は、積層コイル10側の端部での線幅が他の領域27aでの線幅よりも広がって矩形領域27bを形成している導電体層であり、その平面形状はT字状である。矩形領域27bと前述した下部グランド層の矩形領域21bとは、平面視上、互いに重なり合う。

【0064】

図1又は図2に示すように、上部グランド層27における領域27aは、矩形領域27b側の端部を除いて、下部グランド層21における領域21aと共にストリップ線路20の外周面を形成している。ストリップ線路20のうちで領域21a、27aによって外周面が形成されている領域は、シールド型ストリップ線路領域20Sとなっている。

【0065】

図6は、図2に示したVI-VI線断面の概略図である。同図に示すように、ストリップ線路領域20Sにおいては、線路部第1層間絶縁膜22上に形成されたストリップ導体23が線路部第2層間絶縁膜24によって被覆され、さらに、これらが下部グランド層21及び上部グランド層27により被覆されているので、ストリップ導体23を外部電界から確実にシールドすることが容易である。結果として、磁界センサ30のS/N比を高めることが容易になる。なお、図6に示した部材は全て図1又は図2に示されているので、各部材には図1又は図2で用いた参照符号と同じ参照符号を付してある。

【0066】

一方、上部グランド層27の矩形領域27bは、前述した下部グランド層21の矩形領域21bと共同して、ストリップ導体23のうちでこれら2つの矩形領域21b、27bと平面視上重なる領域を外部電界からシールドしている。この矩形領域27bには、前述した積層コイル10の一端（第2コイル形成要素14の一端）が連なっている（図1又は図3参照）。上部グランド層27と第2コイル形成要素14とは、例えば互いに別個に形成することもできるが、大形の導電体層を所定形状にパターンニングすることによって両者を一時に形成した方が簡便である。上部グランド層27の膜厚は、その材料の導電性に応じて、1～5 μ m程度の範囲内で適宜選定可能である。

【0067】

上述した各部材によって構成されるストリップ線路20の特性インピーダンスは、積層コイル10に誘導された起電力を計測するための計測機器にストリップ線路20を接続するのに用いられる高周波ケーブルの特性インピーダンスと同じ値にすることが好ましい。このようにストリップ線路20の特性インピーダンスを選定することにより、伝送損失を低減させることが容易になる。ストリップ線路20の特性インピーダンスは、線路部第1層間絶縁膜22及び線路部第2層間絶縁膜24それぞれの膜厚及び誘電率、並びにストリップ導体23の膜厚及び線幅を適宜選定することによって調整することができる。

【0068】

以上説明した構造を有する磁界センサ30は、周知の微細加工技術により積層コイル10及びストリップ線路20を形成することができるので、その小型化を容易に図ることができる。また、積層コイル10のターン数が1よりも大きいので、ターン数が1以下のループコイルに比べて、積層コイル10の各コイル形成要素を貫く磁束が少なくても比較的大きな起電力を誘導させることが可能である。さらに、積層コイル10は、その構造上、当該積層コイル10を測定対象物に近接させ易い形状及び大きさに設計することが容易なものである。例えば積層コイル10の平面視上の輪郭形状を前述のように矩形にすれば、輪郭形状を円形にした場合に比べて、この積層コイル10を小型化したときでも当該積層コイル10を貫く磁束を増加させることができる。したがって、本形態の磁界センサ30では、小型化による高空間分解能化を図ることが容易である。

【0069】

また、ストリップ線路20の大部分がシールド型ストリップ線路領域20Sとなっているので、ストリップ導体23を外部電界からシールドしてS/N比を高めることが容易である。

【0070】

<第2形態>

図7(a)は、本形態の磁界センサにおける第1コイル形成要素112と、この第1コイル形成要素112に連なるストリップ導体123とを概略的に示す平面図であり、図7(b)は、本形態の磁界センサにおける第2コイル形成要素114と、この第2コイル形成要素114に連なる上部グランド層127とを概略的に示す平面図である。また、図7(c)は、第1コイル形成要素112と第2コイル形成要素114とコンタクトプラグ(同図には現れていない。)とによって形成されるコイル本体C2を概略的に示す平面図である。本形態の磁界センサの構造は、第1コイル形成要素112及び第2コイル形成要素114それぞれの形状を除き、第1形態の磁界センサ30の構造と同様であるので、その全体像や各部材の分解斜視像、あるいは断面構造の図示を省略する。

【0071】

図7(a)に示すように、第1コイル形成要素112は、ターン数が2.5よりもやや大きいコイルであり、その一端はストリップ導体123に連なっている。上述した第1形態の磁界センサ30に比べて第1コイル形成要素112のターン数が増加しているため、この第1コイル形成要素112の線幅は、第1形態の磁界センサ30での第1コイル形成要素12の線幅よりも狭くなっている。ストリップ導体123の線幅は、例えば第1形態の磁界センサ30でのストリップ導体23の線幅と同じである。

【0072】

同様に、図7(b)に示した第2コイル形成要素114のターン数も、第1形態の磁界センサ30での第2コイル形成要素14のターン数よりも増加しているため、第2コイル形成要素114の線幅は、第1形態の磁界センサ30での第2コイル形成要素14の線幅よりも狭くなっている。第2コイル形成要素114の一端は、上部グランド層127に連なっている。上部グランド層127の大きさ及び形状は、例えば第1形態の磁界センサ30での上部グランド層27の大きさ又は形状と同じである。

【0073】

第1コイル形成要素112及び第2コイル形成要素114それぞれのターン数が上述のように選定されていることから、図7(c)に示すように、コイル本体C2のターン数は4よりも大きくなっている。すなわち、本形態の磁界センサでは、積層コイルのターン数が第1形態の磁界センサ30での積層コイル10のターン数よりも増加している。このため、本形態の磁界センサによれば、検出感度を高めて高空間分解能化を図ることが更に容易になる。

【0074】

<第3形態>

図8は、本発明に係る第3形態の磁界センサ230を概略的に示す斜視図である。同図に示すように、本形態の磁界センサ230は、ストリップ線路220の外周面全体が下部グランド層221と上部グランド層227とによって形成されて、当該ストリップ線路220全体がシールド型ストリップ線路領域となっている、という点で第1形態の磁界センサ30と大きく異なる。他の構成は第1形態の磁界センサ30の構成と同様であるので、磁界センサ30の構成部材と機能上共通する部材には図1～図2で用いた参照符号の数値部分に「200」を加えた参照符号を付して、その説明を省略する。

【0075】

この磁界センサ230では、ストリップ線路220全体をシールド型ストリップ線路領域にしたことに伴って、基板201、コイル部第1層間絶縁膜211、及びコイル部第2層間絶縁膜213をそれぞれ除いた各部材の形状が、図9(a)～図9(c)に示すように変更されている。

【0076】

図9 (a) は、上記の磁界センサ230におけるコイル部第1層間絶縁膜211、第1コイル形成要素212、線路部第1層間絶縁膜222、及びストリップ導体223を概略的に示す平面図であり、図9 (b) は、磁界センサ230におけるコイル部第2層間絶縁膜213、第2コイル形成要素214、線路部第2層間絶縁膜224、及び上部グランド層227を概略的に示す平面図である。また、図9 (c) は、積層コイル210におけるコイル本体C3を概略的に示す平面図である。

【0077】

図9 (a) に示すように、ストリップ線路220全体をシールド型ストリップ線路領域にしたことに伴って、ストリップ導体223の平面形状は直線状に変更されている。また、図9 (a) 又は図9 (b) に示すように、線路部第1層間絶縁膜222、線路部第2層間絶縁膜224、及び上部グランド層227それぞれの平面形状は帯状に変更されている。図示を省略しているが、下部グランド層221 (図8参照) の平面形状も帯状に変更されている。下部グランド層221と上部グランド層227とは、平面視したときに互いに重なり合う。

【0078】

図9 (a) に示すように、ストリップ導体223を直線状にしたことに伴って、このストリップ導体223に一端が連なる第1コイル形成要素212のターン数は、第1形態の磁界センサ30での第1コイル形成要素12に比べて僅かに増加している。同様に、第2コイル形成要素214のターン数も、図9 (b) に示すように、第1形態の磁界センサでの第2コイル形成要素14に比べて僅かに増加している。第2コイル形成要素214の一端は、上部グランド層227の一端の中央部に連なっている。これら第1コイル形成要素212と第2コイル形成要素214とは、コイル部第2層間絶縁膜213に形成されたコンタクトプラグ (図示せず。) により互いにヴィアコンタクトしている。

【0079】

これらの結果として、図9 (c) に示すように、積層コイル230におけるコイル本体C3のターン数は3になっている。第1コイル形成要素212においてストリップ導体223に連なっている一端と、第2コイル形成要素214において上部グランド層227に連なっている一端とは、平面視上、互いに重なり合う。なお、図9 (a) ~ 図9 (c) においては、便宜上、各コイル部層間絶縁膜211、213と、このコイル部層間絶縁膜211又は213に連なる線路部層間絶縁膜222、又は224とを合わせた平面視上の輪郭形状を、それぞれ二点鎖線で描いている。

【0080】

上述した構造を有する本形態の磁界センサ230は、第1形態の磁界センサ30と同様の技術的効果を奏する。さらに、本形態の磁界センサ230では積層コイル210 (コイル本体C3) のターン数が3と大きいので、第1形態の磁界センサ30に比べて検出感度を容易に高めることができ、積層コイル210を小型化しても実用的な検出感度を得易いため、小型化による高空間分解能化を図ることが一段と容易になる。また、ストリップ線路220全体がシールド型ストリップ線路領域になっているので、ストリップ導体223全体を外部電界からシールドしてS/N比を更に高めることが可能である。

【0081】

<第4形態>

図10は、本発明に係る第4形態の磁界センサ330を概略的に示す斜視図である。同図に示すように、本形態の磁界センサ330では、積層コイル310と、この積層コイル310に連なるストリップ線路320とが基板301上に形成されている。この磁界センサ330は、積層コイル310におけるコイル本体が3つのコイル形成要素を用いて形成されているという点で、第3形態の磁界センサ230と大きく異なる。ストリップ線路320全体がシールド型ストリップ線路領域となっているという点では第3形態の磁界センサ230と同様である。

【0082】

磁界センサ 330 の構成部材のうち、第 3 形態の磁界センサ 230 の構成部材と機能上共通する部材には図 8 又は図 9 (a) ~ 図 9 (c) で用いた参照符号の数値部分に「100」を加えた参照符号を付して、その説明を省略する。

【0083】

本形態の磁界センサ 330 では、3 つのコイル形成要素を用いてコイル本体を形成するために、コイル部第 1 層間絶縁膜、第 1 コイル形成要素、コイル部第 2 層間絶縁膜、第 2 コイル形成要素、コイル部第 3 層間絶縁膜、及び第 3 コイル形成要素がこの順番で基板 301 上に積層されている。そして、コイル部第 2 層間絶縁膜に形成したコンタクトプラグにより第 1 コイル形成要素と第 2 コイル形成要素とを互いにヴィアコンタクトさせ、コイル部第 3 層間絶縁膜に形成したコンタクトプラグにより第 2 コイル形成要素と第 3 コイル形成要素とを互いにヴィアコンタクトさせることによって、積層コイル 310 が形成されている。また、ストリップ線路 320 は、下部グランド層、線路部第 1 層間絶縁膜、ストリップ導体、線路部第 2 層間絶縁膜、線路部第 3 層間絶縁膜、及び上部グランド層をこの順番で基板 301 上に積層した構造を有している。

【0084】

図 11 (a) は、上記のコイル部第 1 層間絶縁膜 311、第 1 コイル形成要素 312、線路部第 1 層間絶縁膜 322、及びストリップ導体 323 を概略的に示す平面図であり、図 11 (b) は、上記のコイル部第 2 層間絶縁膜 313、第 2 コイル形成要素 314、及び線路部第 2 層間絶縁膜 324 を概略的に示す平面図である。また、図 11 (c) は、上記のコイル部第 3 層間絶縁膜 315、第 3 コイル形成要素 316、線路部第 3 層間絶縁膜 325、及び上部グランド層 327 を概略的に示す平面図であり、図 11 (d) は、積層コイル 310 におけるコイル本体 C4 を概略的に示す平面図である。

【0085】

これら図 11 (a) ~ 図 11 (d) と先に説明した図 9 (a) ~ 図 9 (c) との対比から明らかなように、本形態の磁界センサ 330 における積層コイル 310 は、既に説明した第 3 形態の磁界センサ 230 の積層コイル 210 における第 1 コイル形成要素 212 とコイル部第 2 層間絶縁膜 213 との間に、図 11 (b) に示すコイル部第 2 層間絶縁膜 313 と第 2 コイル形成要素 314 とを挿入した構造を有している。基板 301 を基準にしたとき、3 つのコイル形成要素 312、314、316 のうちの第 1 コイル形成要素 312 が最下層のコイル形成要素に相当し、第 3 コイル形成要素 316 が最上層のコイル形成要素に相当する。また、本形態の磁界センサ 330 におけるストリップ線路 320 は、第 3 形態の磁界センサ 230 のストリップ線路 220 におけるストリップ導体 223 と線路部第 2 層間絶縁膜 224 との間に、図 11 (b) に示す線路部第 2 層間絶縁膜 324 を挿入した構造を有している。

【0086】

図 11 (b) に示すように、コイル部第 2 層間絶縁膜 313 上に形成されている第 2 コイル形成要素 314 は、ターン数が 1 よりも僅かに大きいコイルである。この第 2 コイル形成要素 314 は、コイル部第 2 層間絶縁膜 313 に形成されたコンタクトプラグ (図示せず。) により第 1 コイル形成要素 312 と互いにヴィアコンタクトしており、かつ、コイル部第 3 層間絶縁膜 315 に形成されたコンタクトプラグ (図示せず。) により第 3 コイル形成要素 316 と互いにヴィアコンタクトしている。その結果として、図 11 (d) に示すように、コイル本体 C4 のターン数は、第 3 形態の磁界センサ 230 におけるコイル本体 C3 のターン数よりも増加して、4 となっている。

【0087】

なお、図 11 (a)、図 11 (b)、又は図 11 (c) においては、便宜上、各コイル部層間絶縁膜 311、313、315 と、このコイル部層間絶縁膜 311、313、又は 315 に連なる線路部層間絶縁膜 322、324、又は 325 とを合わせた平面視上の輪郭形状を、それぞれ二点鎖線で描いている。

【0088】

図 12 は、本形態の磁界センサ 330 におけるストリップ線路 320 の断面構造を示す

概略図である。同図に示すように、ストリップ導体 323 は線路部第 1 層間絶縁膜 322 上に形成されており、このストリップ導体 323 は線路部第 2 層間絶縁膜 324 により被覆されている。また、線路部第 2 層間絶縁膜 324 上には線路部第 3 層間絶縁膜 325 が積層されている。このストリップ線路 320 においては、線路部第 1 層間絶縁膜 322 が下部層間絶縁膜に相当し、線路部第 2 層間絶縁膜 324 と線路部第 3 層間絶縁膜 325 とが上部層間絶縁膜 U I に相当する。ストリップ線路 320 の特性インピーダンスを所望の値に容易に制御可能であるという観点から、下部層間絶縁膜である線路部第 1 層間絶縁膜 322 の膜厚と上部層間絶縁膜 U I の膜厚を実質的に同じ値にすることが好ましい。

【0089】

上述した構造を有する本形態の磁界センサ 330 は、第 3 形態の磁界センサ 230 と同様の技術的効果を奏する。さらに、磁界センサ 330 での積層コイル 310 (コイル本体 C4) のターン数が 4 と大きいので、第 3 形態の磁界センサ 230 に比べて検出感度を高めることが容易であり、積層コイル 310 を小型化しても実用的な検出感度を得易いため、小型化による高空間分解能化を図ることが一段と容易になる。

【0090】

<第 5 形態>

図 13 は、本発明に係る第 5 形態の磁界センサ 430 を概略的に示す斜視図である。同図に示すように、本形態の磁界センサ 430 では、積層コイル 410 と、この積層コイル 410 に連なるストリップ線路 420 とが基板 401 上に形成されている。この磁界センサ 430 は、積層コイル 410 におけるコイル本体が 4 つのコイル形成要素を用いて形成されているという点で、第 3 形態の磁界センサ 230 と大きく異なる。ストリップ線路 420 全体がシールド型ストリップ線路領域となっているという点では、第 3 形態の磁界センサ 230 と同様である。

【0091】

磁界センサ 430 の構成部材のうち、第 3 形態の磁界センサ 230 の構成部材と機能上共通する部材には図 8 又は図 9 (a) ~ 図 9 (c) で用いた参照符号の数値部分に「200」を加えた参照符号を付して、その説明を省略する。ただし、線路部第 2 層間絶縁膜については新たな参照符号「423」を付し、ストリップ導体については新たな参照符号「424」を付してある。

【0092】

本形態の磁界センサ 430 では、4 つのコイル形成要素を用いてコイル本体を形成するために、コイル部第 1 層間絶縁膜と、第 1 コイル形成要素と、コイル部第 2 層間絶縁膜と、第 2 コイル形成要素及びリード部と、コイル部第 3 層間絶縁膜と、第 3 コイル形成要素と、コイル部第 4 層間絶縁膜と、第 4 コイル形成要素とをこの順番で基板 401 上に積層し、かつ、コイル部層間絶縁膜を介して互いに隣り合う 2 つのコイル形成要素を当該コイル部層間絶縁膜に形成したコンタクトプラグにより互いにヴィアコンタクトさせることによって、積層コイル 410 が形成されている。また、ストリップ線路 420 は、下部グラウンド層、線路部第 1 層間絶縁膜、線路部第 2 層間絶縁膜、ストリップ導体、線路部第 3 層間絶縁膜、線路部第 4 層間絶縁膜、及び上部グラウンド層をこの順番で基板 401 上に積層した構造を有している。

【0093】

図 14 (a) は、上記のコイル部第 1 層間絶縁膜 411、第 1 コイル形成要素 412、及び線路部第 1 層間絶縁膜 422 を概略的に示す平面図である。同図に示すように、コイル部第 1 層間絶縁膜 411 上に形成されている第 1 コイル形成要素 412 のターン数は、1.5 よりも大きい。コイル部第 1 層間絶縁膜 411 には、平面形状が帯状の線路部第 1 層間絶縁膜 422 が連なっている。

【0094】

図 14 (b) は、上記のコイル部第 2 層間絶縁膜 413、第 2 コイル形成要素 414、引き出し部 414R、線路部第 2 層間絶縁膜 423、及びストリップ導体 424 を概略的に示す平面図である。同図に示すように、コイル部第 2 層間絶縁膜 413 上に形成されて

いる第2コイル形成要素414のターン数は、1.5よりも大きく、この第2コイル形成要素414に近接して、引き出し部414Rがコイル部第2層間絶縁膜413上に形成されている。

【0095】

第2コイル形成要素414の一端は、コイル部第2層間絶縁膜413に形成されたコンタクトプラグ（図示せず。）により第1コイル形成要素412の一端とヴィアコンタクトしており、この第1コイル形成要素412の他端は、コイル部第2層間絶縁膜413に形成された他のコンタクトプラグ（図示せず。）により引き出し部414Rの一端とヴィアコンタクトしている。引き出し部414Rの他端は、線路部第2層間絶縁膜423上に形成されたストリップ導体424の一端に連なっている。

【0096】

図14(c)は、前述したコイル部第3層間絶縁膜415、第3コイル形成要素416、及び線路部第3層間絶縁膜425を概略的に示す平面図である。同図に示すように、コイル部第3層間絶縁膜415上に形成されている第3コイル形成要素416のターン数は、1.5よりも大きい。この第3コイル形成要素416の一端は、コイル部第3層間絶縁膜415に形成されたコンタクトプラグ（図示せず。）により、第2コイル形成要素414の一端とヴィアコンタクトしている。

【0097】

図14(d)は、前述したコイル部第4層間絶縁膜417、第4コイル形成要素418、線路部第4層間絶縁膜426、及び上部グランド層427を概略的に示す平面図である。同図に示すように、コイル部第4層間絶縁膜417上に形成されている第4コイル形成要素418のターン数は、1.5よりも大きい。この第4コイル形成要素418の一端は、コイル部第4層間絶縁膜417に形成されたコンタクトプラグ（図示せず。）により第3コイル形成要素416の一端とヴィアコンタクトしており、他端は上部グランド層427に連なっている。

【0098】

図14(e)に示すように、本形態の磁界センサ430における積層コイル410のコイル本体C5はターン数が7のコイルである。ただし、各コイル形成要素412、414、416、418が平面視上互いに重なり合う領域を有していることから、同図においては第1コイル形成要素412が現れていない。4つのコイル形成要素412、414、416、418のうちの第4コイル形成要素418が最上層のコイル形成要素に相当し、残り3つのコイル形成要素412、414、416では第2コイル形成要素414が真中のコイル形成要素に相当する。

【0099】

なお、図14(a)、図14(b)、図14(c)、又は図14(d)においては、便宜上、各コイル部層間絶縁膜411、413、415、417とこれに連なる線路部層間絶縁膜422、423、425、又は426とを合わせた平面視上の輪郭形状を、それぞれ二点鎖線で描いている。

【0100】

図15は、本形態の磁界センサ430におけるストリップ線路420の断面構造を示す概略図である。同図に示すように、ストリップ線路420では、下部グランド層421上に線路部第1層間絶縁膜422と線路部第2層間絶縁膜423とがこの順番で積層され、その上にストリップ導体424が形成されている。このストリップ導体424は線路部第3層間絶縁膜425により被覆されており、その上に線路部第4層間絶縁膜426が積層されている。下部グランド層421と上部グランド層427とは、互いに共同して、ストリップ線路420の外周面全体を形成している。

【0101】

ストリップ線路420においては、線路部第1層間膜422と線路部第2層間絶縁膜423とが下部層間絶縁膜L1を形成しており、線路部第3層間絶縁膜425と線路部第4層間絶縁膜426とが上部層間絶縁膜U1を形成している。ストリップ線路420の特性

インピーダンスを所望の値に容易に制御可能であるという観点から、下部層間絶縁膜 L I の膜厚と上部層間絶縁膜 U I の膜厚を実質的に同じ値にすることが好ましい。

【0102】

上述した構造を有する本形態の磁界センサ 430 は、第 4 形態の磁界センサ 330 と同様の技術的効果を奏する。さらに、磁界センサ 430 での積層コイル 410（コイル本体 C5）のターン数が 7 と大きいので、第 4 形態の磁界センサ 330 に比べて検出感度を高めることが容易であり、積層コイル 410 を小型化しても実用的な検出感度を得易いため、小型化による高空間分解能化を図ることが一段と容易になる。

【0103】

<変形例>

本発明の磁界センサは、上述した第 1～5 形態の各磁界センサに限定されるものではない。例えば、個々のコイル形成要素の形状及びターン数は、積層コイル全体として同じ向きに巻回されていさえすれば、作製しようとする磁界センサに求められる大きさ、空間分解能等に応じて、所望の形状及びターン数（ターン数が 1 未満である場合を含む。）とすることができる。ターン数の大きい積層コイルを効率よく得るうえからは、個々のコイル形成要素のターン数を 1 以上にすること、換言すれば、積層コイルのターン数をコイル形成要素の総数以上にすることが好ましい。また、積層コイルを構成するコイル形成要素の総数も、作製しようとする磁界センサに求められる大きさ、空間分解能等に応じて適宜選定可能である。

【0104】

例えば半導体集積回路から発せられるメガヘルツ（MHz）帯からギガヘルツ（GHz）帯の電磁波の発生場所を特定するためには本発明の磁界センサを用いる場合には、積層コイルの厚さ（基板を除く。）を 2.5～20 μm 程度とすることが好ましいので、積層コイルの厚さが所望の厚さに収まるように、個々のコイル形成要素の形状及びターン数並びにコイル形成要素の総数が適宜選定される。

【0105】

第 5 形態の磁界センサ 430 におけるように 1 つのコイル形成要素に近接して引き出し部 414 R（図 14（b）参照）を設ける場合、この引き出し部 414 R はコイル形成要素の 1 つとみなしてもよいし、ストリップ導体の一部とみなしてもよい。

【0106】

積層コイルの一端は、上述した第 1～5 形態のいずれの磁界センサにおいても上部グラウンド層に連なっているが、上部グラウンド層に代えて下部グラウンド層に連ならせることも可能である。この場合には、各磁界センサでのコイル形成要素（第 5 形態の磁界センサ 430 においては、引き出し部 414 R を含める。）の配置パターンを、例えば基板の厚方向に 180° 回転させる。

【0107】

ストリップ導体を外部電界からシールドするという観点からは、ストリップ線路全体をシールド型ストリップ線路領域とすることが好ましいが、第 1 形態又は第 2 形態の磁界センサのように積層コイル側の端部を除いた残りの領域をシールド型ストリップ線路領域にすることも、磁界センサの生産性を高めるという観点からは好ましい。

【0108】

また、磁界センサの生産性を高めるうえからは、ストリップ線路における線路部層間絶縁膜の層数を積層コイルにおけるコイル部層間絶縁膜の層数と同数にすることが好ましいが、下部層間絶縁膜に相当する層間絶縁膜と上部層間絶縁膜に相当する層間絶縁膜とがあれば、線路部層間絶縁膜の層数をコイル部層間絶縁膜の層数よりも少なくすることも可能である。図 13～図 15 を用いて説明した第 5 形態の磁界センサ 430 における積層コイル 410 のように、最下層のコイル形成要素とストリップ導体との間にコンタクトプラグ及び引き出し部を介在させる場合には、基板が電気絶縁性を有しているので、図 13 又は図 14 に示したコイル部第 1 層間絶縁膜 411 に相当する層間絶縁膜及び線路部第 1 層間絶縁膜 422 に相当する層間絶縁膜の少なくとも一方を省略することも可能である。

【0109】

耐久性の高い磁界センサを得るという観点からは、パッシベーション膜により積層コイル及びストリップ線路を被覆することが好ましい。このパッシベーション膜は、積層コイル及びストリップ線路それぞれの外表面に、例えばPVD、CVDによりアルミナ等を膜厚10～30 μ m程度の範囲内で堆積させることにより、形成することができる。

【0110】

その他、種々の変形、修飾、組み合わせ等が可能である。なお、本発明の磁界センサは、磁界計測、電磁妨害(EMI)対策のための高周波ノイズ電流の計測、高周波ノイズ電流の経路の特定等に利用することができる他、微細領域での電磁耐性試験のために使用される微小な磁界発生器として利用することも可能である。本発明の磁界センサは高空間分解能化を図ることが容易なものであるため、高空間分解能化することにより、電子回路における個々の配線近傍で磁界計測を行って当該配線に流れる電流値を配線毎に求めることも容易になる。電流値を配線毎に求めることができれば、その電流値から電子回路を評価することができるので、電磁妨害(EMI)対策も含めて、開発の早期から電子回路の最適化を図ることが容易になる。

【0111】

図16は、前述した第1形態の磁界センサ30の使用形態の一例を概略的に示す斜視図である。同図は、パッケージを開封した半導体集積回路基板500での高周波ノイズ電流の経路を特定する際の近傍磁界計測の様子を示すものである。

【0112】

パッケージを開封することにより剥き出しの状態になった半導体集積回路基板500に磁界センサ30を近づけ、この磁界センサ30を前後左右に走査させることにより、詳細な磁界分布構造を検知することが可能となる。磁界センサ30における積層コイル10の上面を半導体集積回路基板500の所望の配線505の側面と平行にすると、配線505に電流Iが流れることによって発生する磁界Hを測定することができる。また、同じ測定地点において、磁界センサ30における積層コイル10の上面を配線505と平行にして磁界を計測し、さらに、積層コイル10の上面を配線505と直角にして磁界を計測することにより、水平方向の磁界成分の大きさを計測することができる。磁界センサ30は、既に説明したように小型化が容易なものであり、この磁界センサ30を小型化すると半導体集積回路基板500中の所望の配線に積層コイル10を近接させることが可能になるため、高い空間分解能を得ることができる。本発明の磁界センサであれば、第1形態の磁界センサ30に限らず、同様の近傍磁界計測が可能である。なお、図16中の参照符号510は、ボンディングワイヤを示している。

【図面の簡単な説明】

【0113】

【図1】本発明に係る第1形態の磁界センサを概略的に示す分解斜視図である。

【図2】図1に示した磁界センサを概略的に示す斜視図である。

【図3】図2に示したIII-III線断面の概略図である。

【図4】図1に示した磁界センサの積層コイルにおけるコイル本体を概略的に示す平面図である。

【図5】図1に示した磁界センサにおける積層コイル側でのストリップ導体と下部グラウンド層との位置関係を概略的に示す平面図である。

【図6】図2に示したVI-VI線断面の概略図である。

【図7】図7(a)は、第2形態の磁界センサにおける第1コイル形成要素とストリップ導体とを概略的に示す平面図であり、図7(b)は、第2形態の磁界センサにおける第2コイル形成要素と上部グラウンド層とを概略的に示す平面図であり、図7(c)は、第2形態の磁界センサの積層コイルにおけるコイル本体を概略的に示す平面図である。

【図8】本発明に係る第3形態の磁界センサを概略的に示す斜視図である。

【図9】図9(a)は、図8に示した磁界センサにおけるコイル部第1層間絶縁膜、

第1コイル形成要素、線路部第1層間絶縁膜、及びストリップ導体を概略的に示す平面図であり、図9(b)は、図8に示した磁界センサにおけるコイル部第2層間絶縁膜、第2コイル形成要素、線路部第2層間絶縁膜、及び上部グランド層を概略的に示す平面図であり、図9(c)は、図8に示した磁界センサの積層コイルにおけるコイル本体を概略的に示す平面図である。

【図10】本発明に係る第4形態の磁界センサを概略的に示す斜視図である。

【図11】図11(a)は、図10に示した磁界センサにおけるコイル部第1層間絶縁膜、第1コイル形成要素、線路部第1層間絶縁膜、及びストリップ導体を概略的に示す平面図であり、図11(b)は、図10に示した磁界センサにおけるコイル部第2層間絶縁膜、第2コイル形成要素、及び線路部第2層間絶縁膜を概略的に示す平面図であり、図11(c)は、図10に示した磁界センサにおけるコイル部第3層間絶縁膜、第3コイル形成要素、線路部第3層間絶縁膜、及び上部グランド層を概略的に示す平面図であり、図11(d)は、図10に示した磁界センサの積層コイルにおけるコイル本体を概略的に示す平面図である。

【図12】図10に示した磁界センサにおけるストリップ線路の断面構造を示す概略図である。

【図13】本発明に係る第5形態の磁界センサを概略的に示す斜視図である。

【図14】図14(a)は、図13に示した磁界センサにおけるコイル部第1層間絶縁膜、第1コイル形成要素、及び線路部第1層間絶縁膜を概略的に示す平面図であり、図14(b)は、図13に示した磁界センサにおけるコイル部第2層間絶縁膜、第2コイル形成要素、引き出し部、線路部第2層間絶縁膜、及びストリップ導体を概略的に示す平面図であり、図14(c)は、図13に示した磁界センサにおけるコイル部第3層間絶縁膜、第3コイル形成要素、及び線路部第3層間絶縁膜を概略的に示す平面図であり、図14(d)は、図13に示した磁界センサにおけるコイル部第4層間絶縁膜、第4コイル形成要素、線路部第4層間絶縁膜、及び上部グランド層を概略的に示す平面図であり、図14(e)は、図13に示した磁界センサの積層コイルにおけるコイル本体を概略的に示す平面図である。

【図15】図13に示した磁界センサにおけるストリップ線路の断面構造を示す概略図である。

【図16】図1に示した磁界センサの使用形態の一例を概略的に示す斜視図である。

【符号の説明】

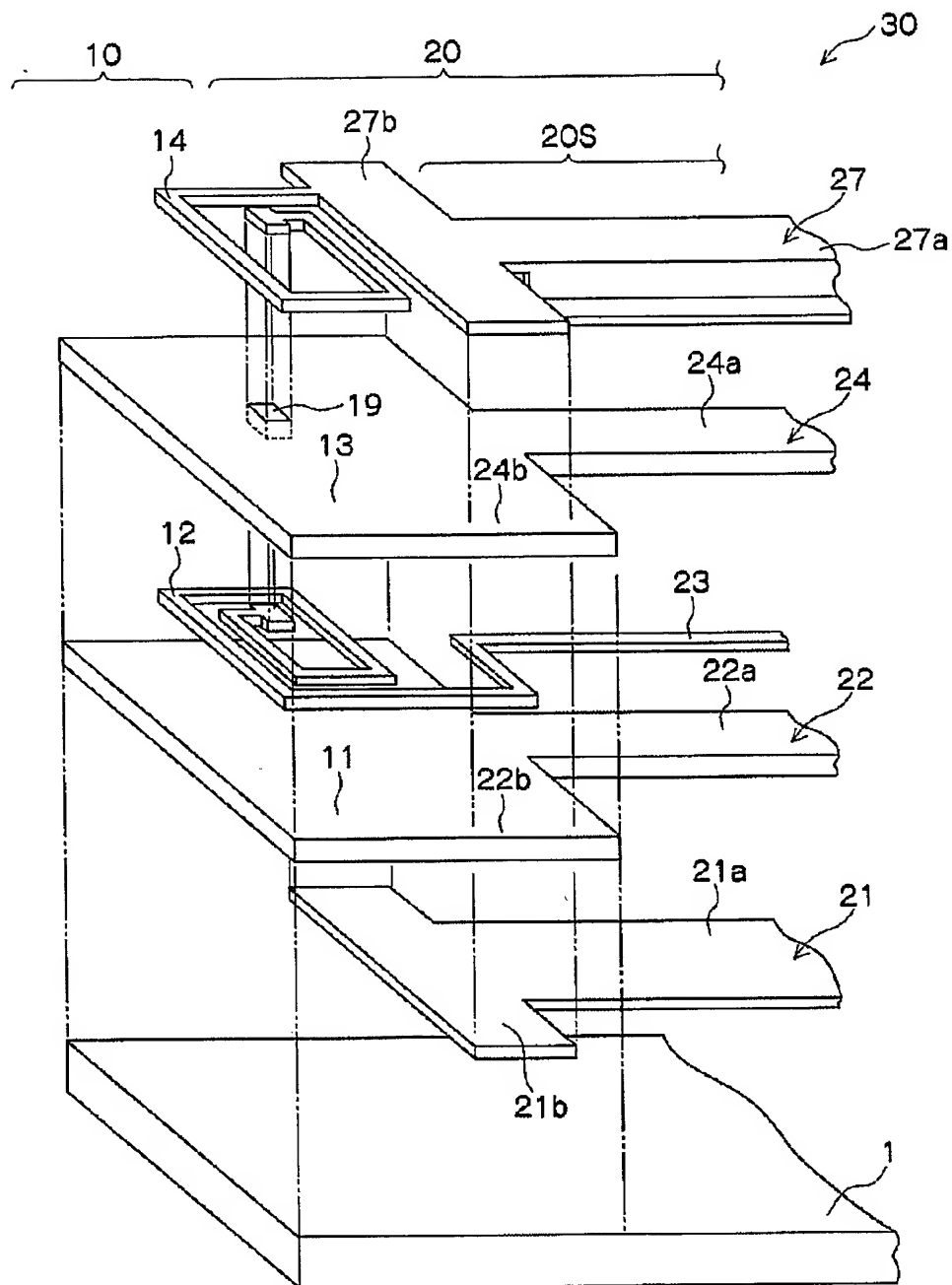
【0114】

- 1、201、301、401 基板
- 10、210、310、410 積層コイル
- 11、211、311、411 コイル部第1層間絶縁膜
- 12、112、212、312、412 第1コイル形成要素
- 13、213、313、413 コイル部第2層間絶縁膜
- 14、114、214、314、414 第2コイル形成要素
- 19 コンタクトプラグ
- 20、220、320、420 ストリップ線路
- 20s シールド型ストリップ線路領域
- 21、221、321、421 下部グランド層
- 22、222、322、422 線路部第1層間絶縁膜
- 23、123、223、323、424 ストリップ導体
- 24、224、324、423 線路部第2層間絶縁膜
- 27、127、227、327、427 上部グランド層
- 30、230、330、430 磁界センサ
- 315、415 コイル部第3層間絶縁膜
- 316、416 第3コイル形成要素
- 325、425 線路部第3層間絶縁膜

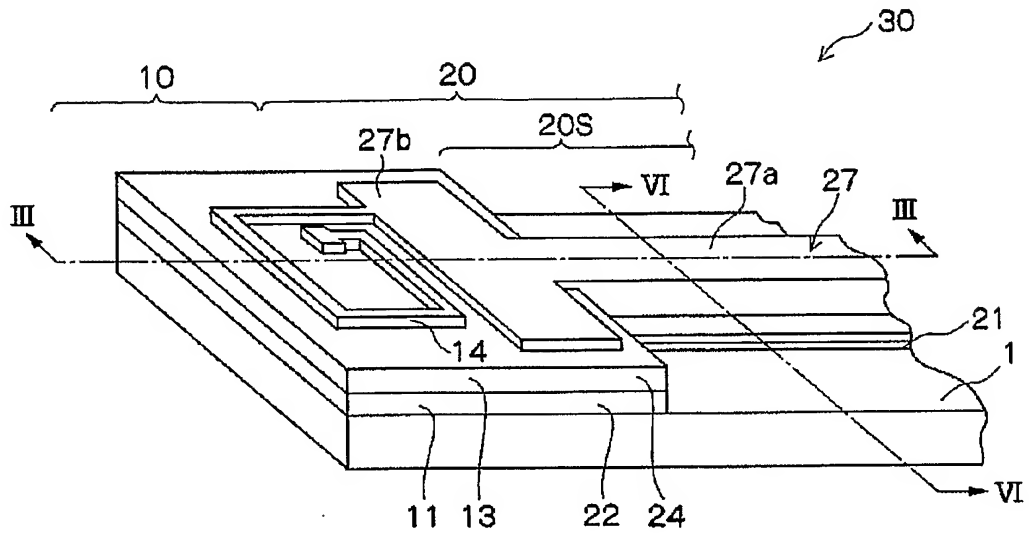
4 1 7 コイル部第 4 層間絶縁膜
4 1 8 第 4 コイル形成要素
4 2 6 線路部第 4 層間絶縁膜
L I 下部層間絶縁膜
U I 上部層間絶縁膜

【書類名】 図面

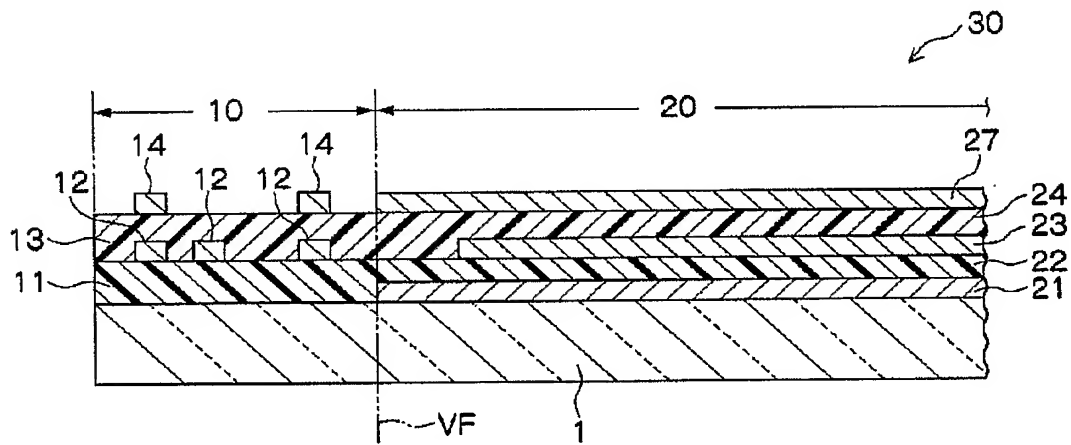
【図 1】



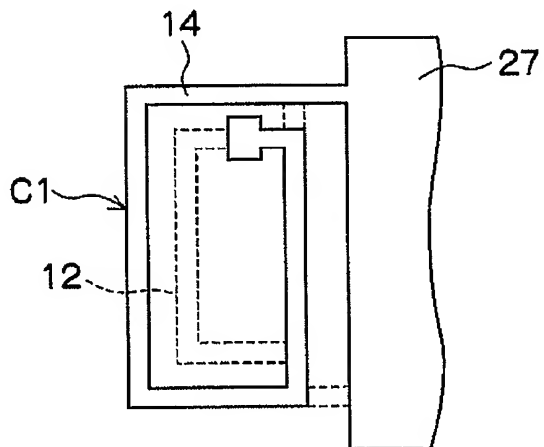
【図 2】



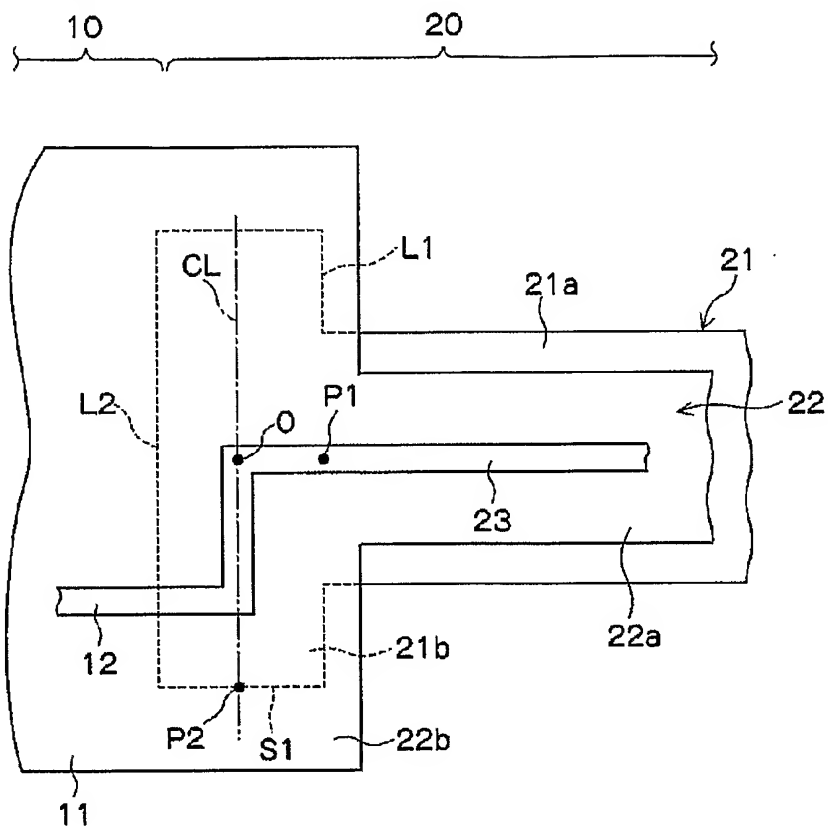
【図 3】



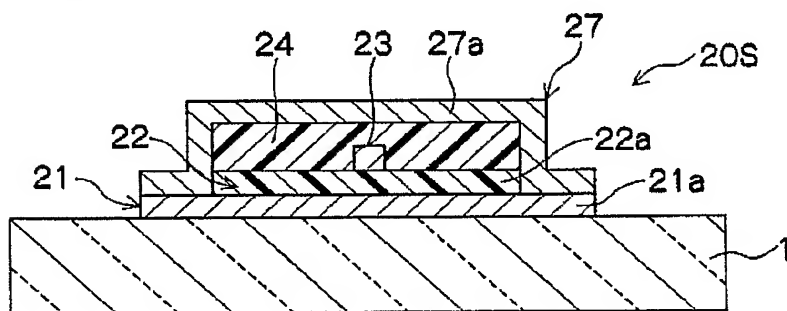
【図 4】



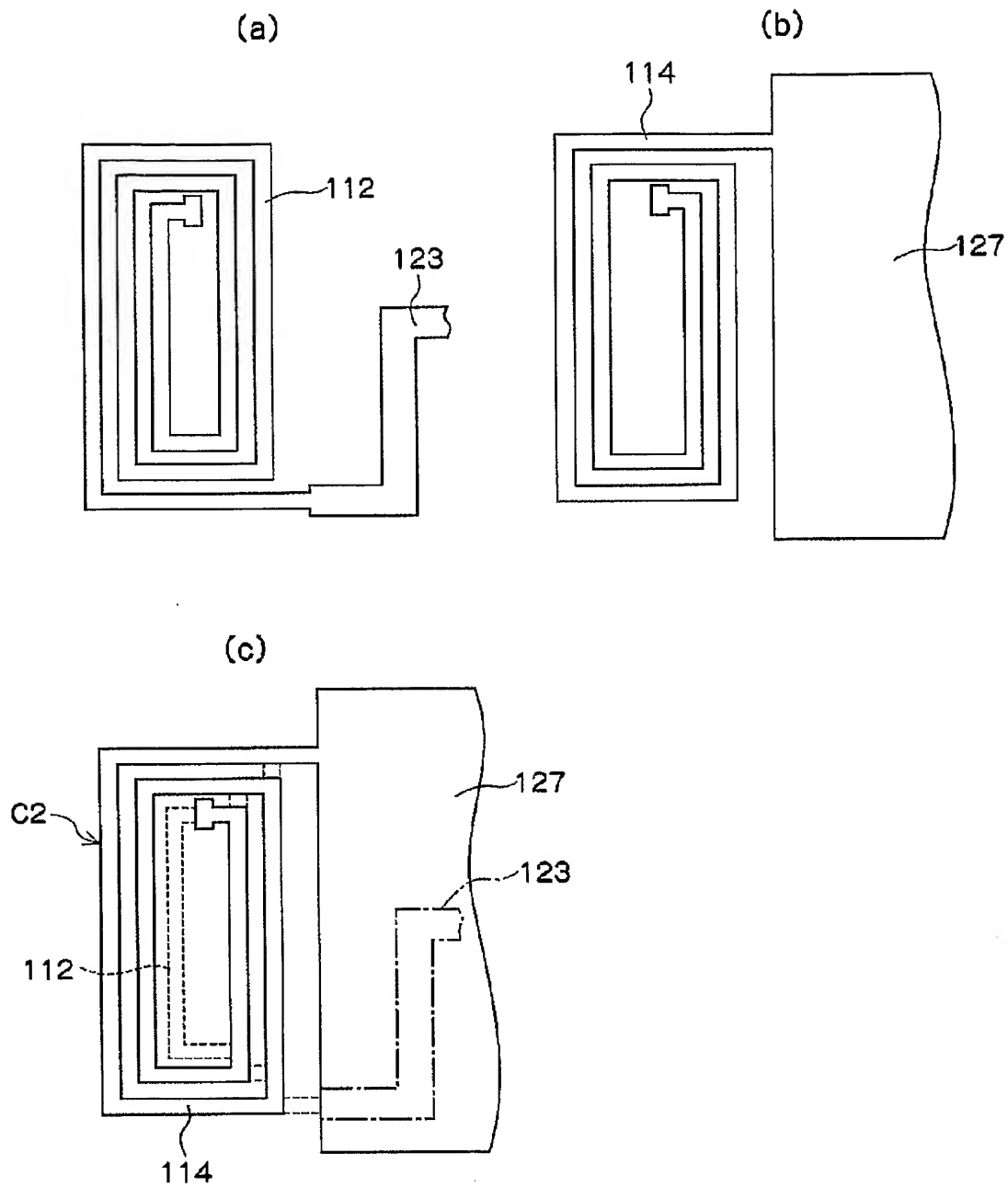
【図 5】



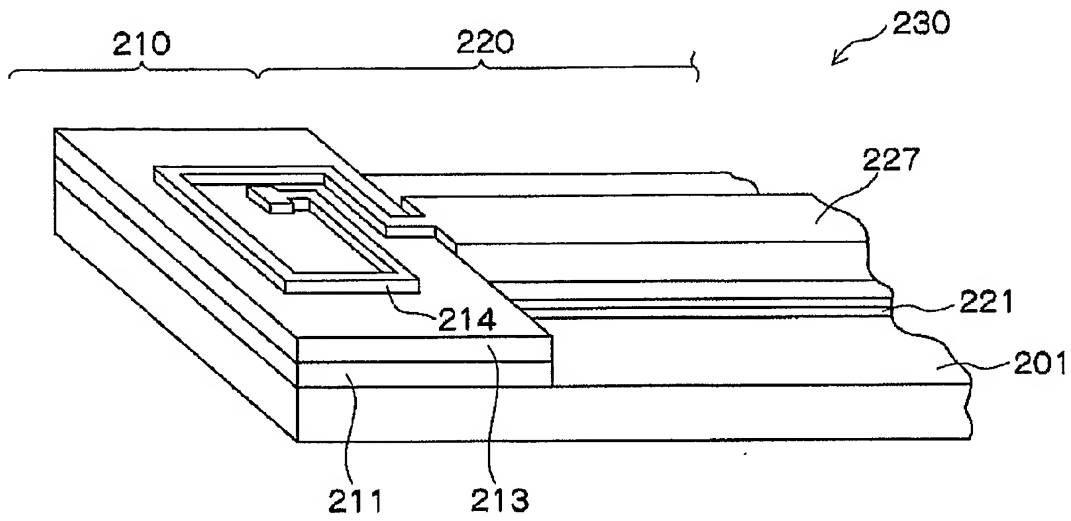
【図 6】



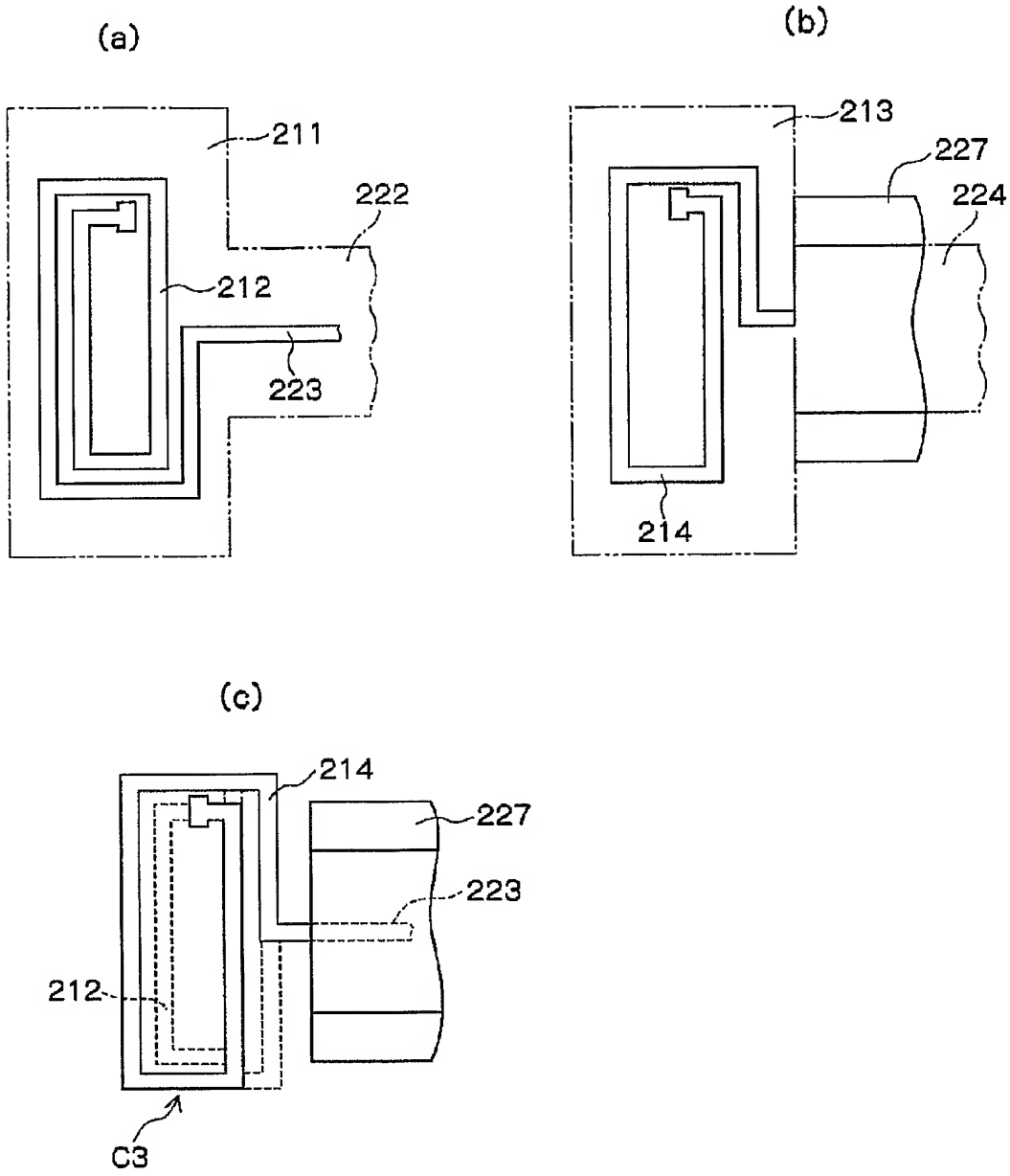
【図 7】



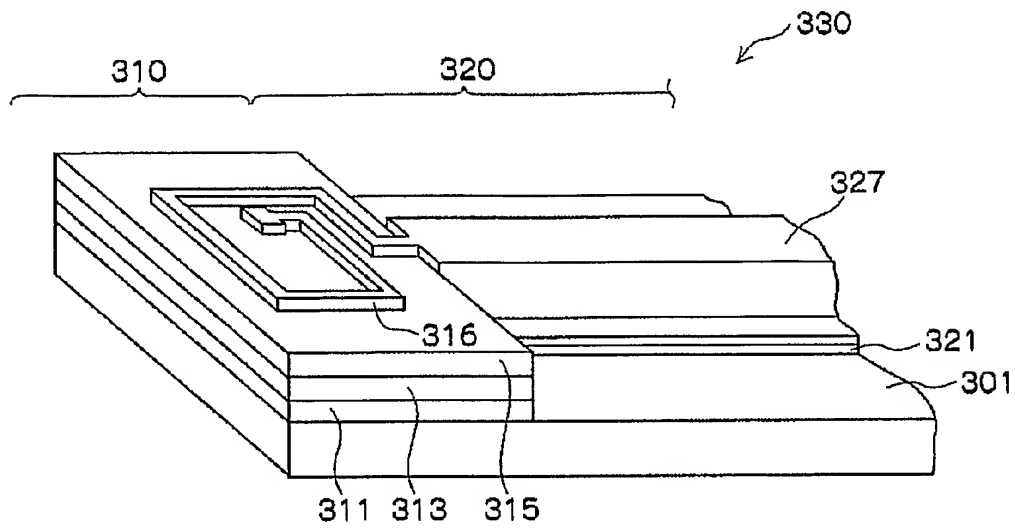
【図 8】



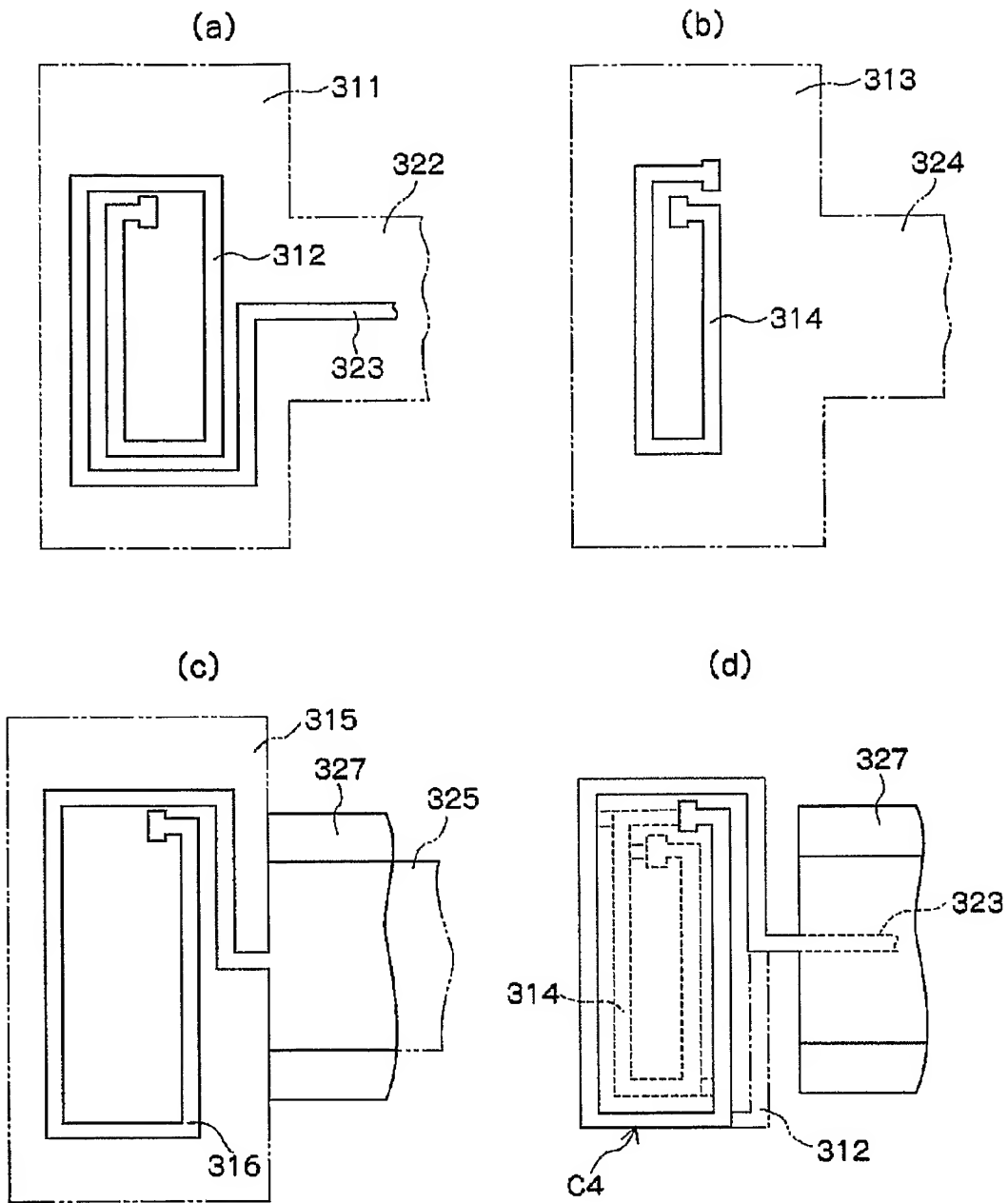
【図 9】



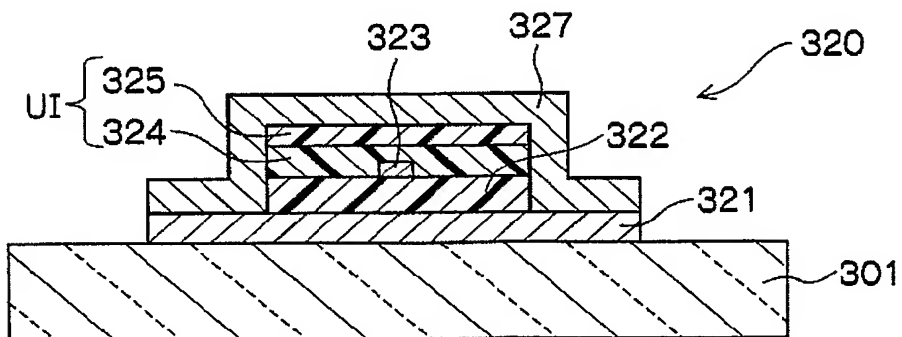
【図 10】



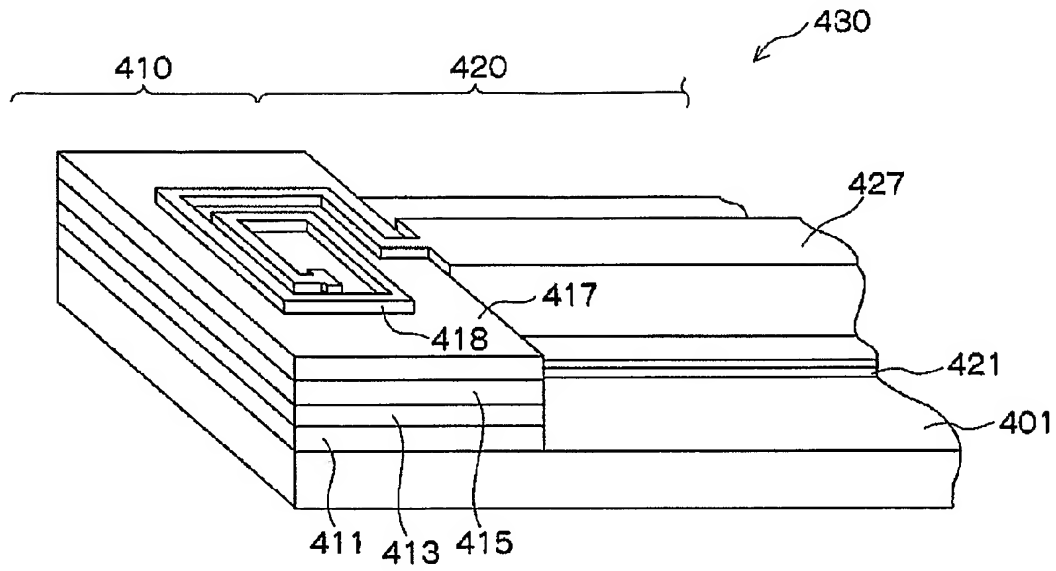
【図 1 1】



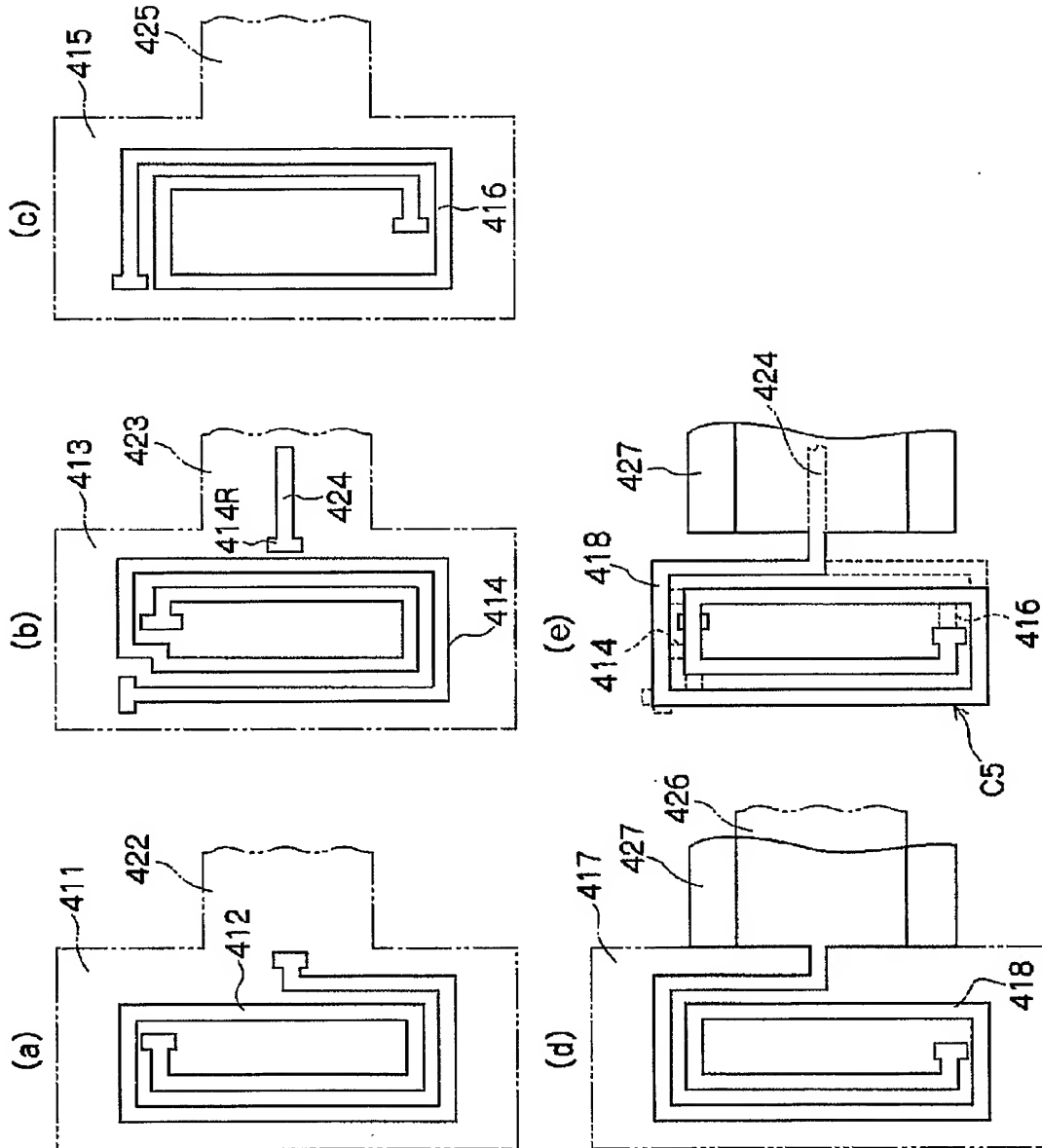
【図 1 2】



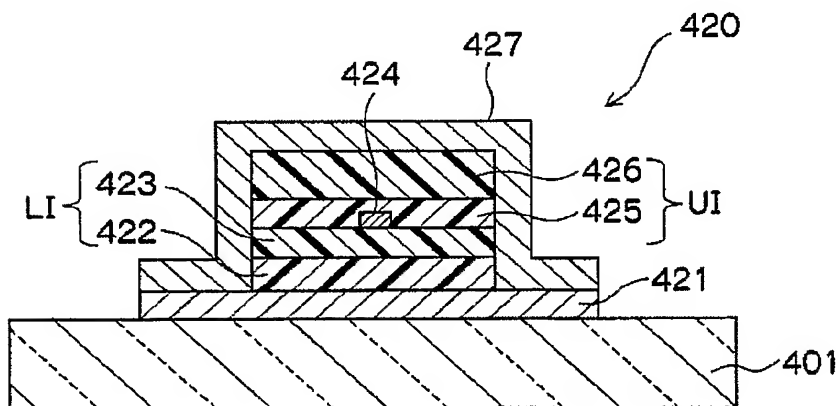
【図 13】



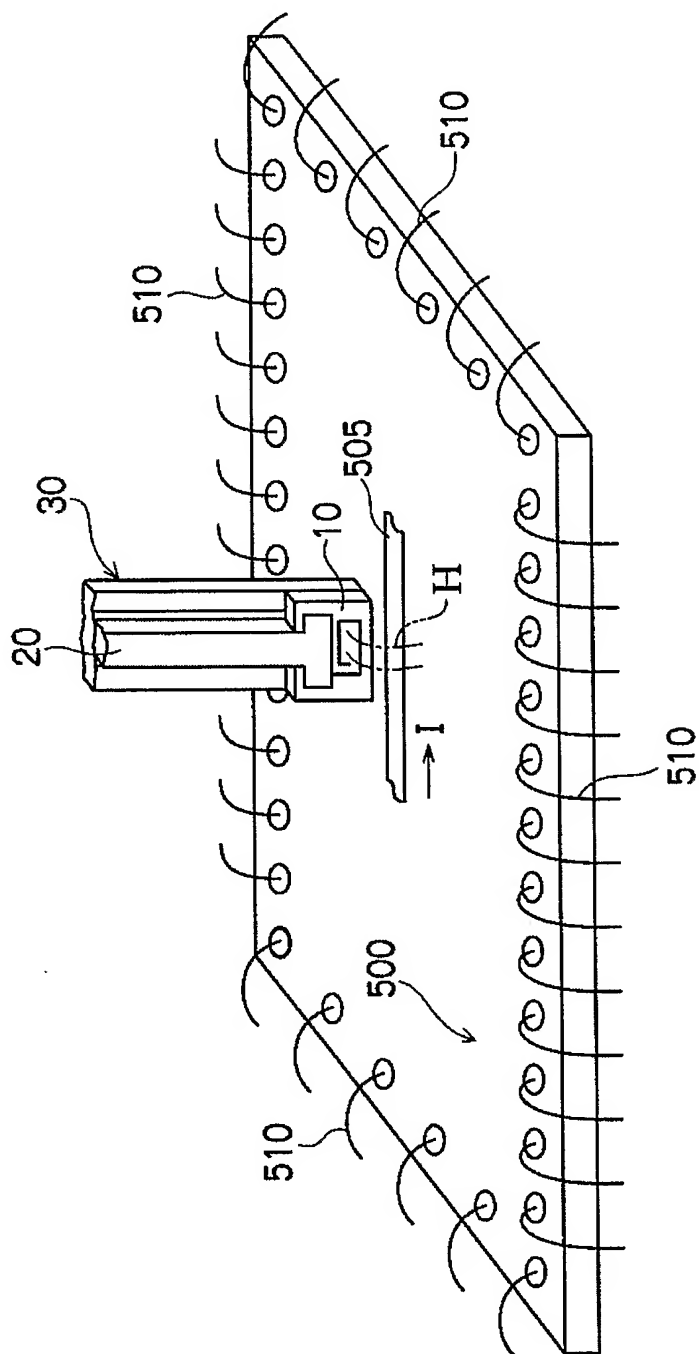
【図 14】



【図 15】



【図 16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高空間分解能化を図ることが容易な磁界センサを提供する。

【解決手段】 導電体層により形成した少なくとも2つのコイル形成要素を、隣り合うもの同士の上に層間絶縁膜を介した状態で、かつ隣り合うもの同士をビアコンタクトさせた状態で基板上に積層して、1よりも大きなターン数を有する積層コイルを形成し、また、下部グランド層、下部層間絶縁膜、ストリップ導体、上部層間絶縁膜、及び上部グランド層をこの順番で前記基板上に積層することによりストリップ線路を形成し、これら積層コイル及びストリップ線路を形成するにあたって前記積層コイルの一端を前記下部グランド層及び前記上部グランド層のいずれか一方のグランド層に連ならせ、前記積層コイルの他端を前記ストリップ導体に連ならせることによって、解決した。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 4 - 1 0 6 5 2 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 2 3 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

氏 名

日本電気株式会社